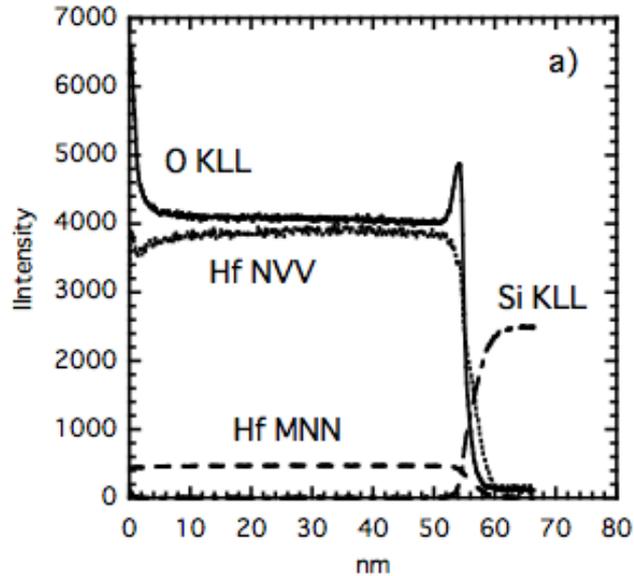


研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO₂/Si基板の分析” に掲載されている Fig.7
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

DOI

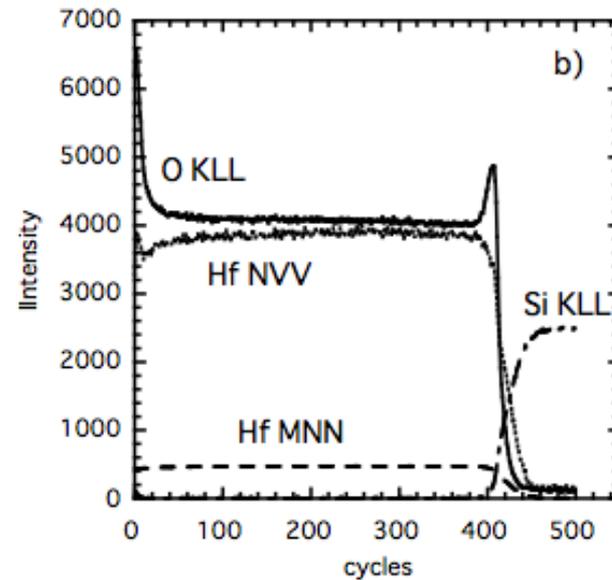
<https://doi.org/10.1384/jsa.24.192>

荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



AES depth profile of the HfO₂:55nm/Si substrate using the ultra low angle incident beam method with the argon ion energy of 2.0 keV.

Horizontal axis is nm.

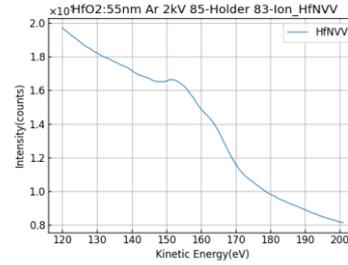


AES depth profile of the HfO₂:55nm/Si substrate using the ultra low angle incident beam method with the argon ion energy of 2.0 keV.

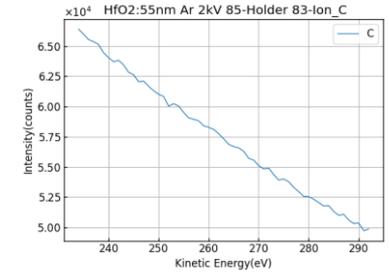
Horizontal axis is cycles.

- a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig.7 に相当し, 横軸は nm である.
b) は横軸を測定回数で表したものであり, 横軸を nm に変換する前のプロファイルである.
Raw data ファイルは, b) に対応している.

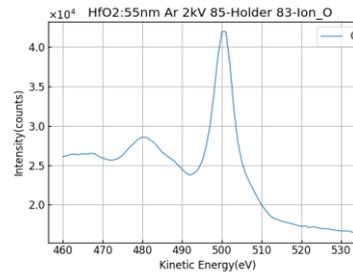
Energy (eV)	Intensity		
120	197079	176	103888
121	195428	177	102392
122	193534	178	100834
123	192044	179	99347
124	190507	180	98243
125	188884	181	97288
126	187183	182	96157
127	185785	183	95038
128	184733	184	94401
129	183174	185	93296
130	182122	186	92397
131	180996	187	91690
132	179834	188	90813
133	179075	189	89973
134	178056	190	89005
135	176977	191	88190
136	176084	192	87272
137	174925	193	86643
138	174256	194	85675
139	173111	195	84961
140	171717	196	84343
141	170346	197	83670
142	169234	198	83086
143	168585	199	82467
144	167854	200	81839
145	167086	201	81420
146	165934		
147	165243		
148	165243		
149	165046		
150	165517		
151	166361		
152	166310		
153	165593		
154	164187		
155	162767		
156	160555		
157	157592		
158	154900		
159	151561		
160	148839		
161	146724		
162	144584		
163	142341		
164	139310		
165	135837		
166	131799		
167	127542		
168	123494		
169	119580		
170	116189		
171	113121		
172	110818		
173	108652		
174	107025		
175	105538		



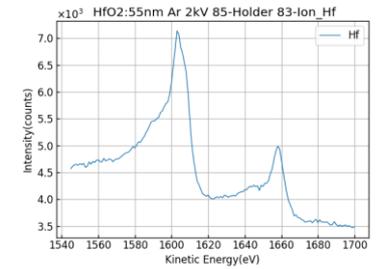
Raw data of Hf-NV



Raw data of C



Raw data of O



Raw data of Hf

Raw data の図化

Hf-NV Raw data ファイルの構造